

关键指标

射频&本振频率：6~18GHz

中频频率：DC~5GHz

本振功率：13dBm

变频损耗：8dB

LO/RF 隔离度：40dB

芯片尺寸：1.2mm×0.9mm

产品简介

HG126HB/HG126HB(M)是一款无源双平衡混频器芯片，射频和本振频率为6~18GHz，中频频率为DC~5GHz，变频损耗为8dB。

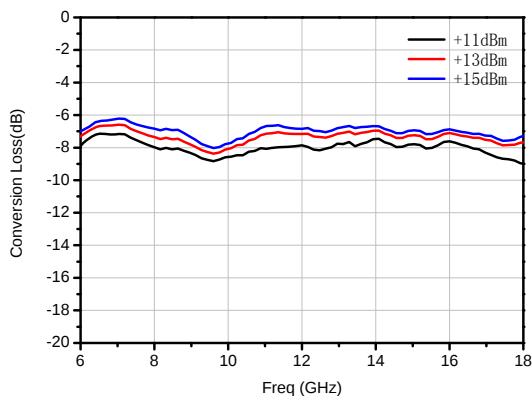
电性能（ $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $\text{LO}=+13\text{dBm}$ ， $\text{IF}=100\text{MHz}$ ）

指标	最小值	典型值	最大值
RF&LO 频率(GHz)	6~18		
IF 频率(GHz)	DC~5		
变频损耗(dB)	—	8	—
LO~RF 隔离度(dB)	—	40	—
LO~IF 隔离度(dB)	—	40	—
RF~IF 隔离度(dB)	—	15	—
输入 1dB 压缩点(dBm)	10	12	—

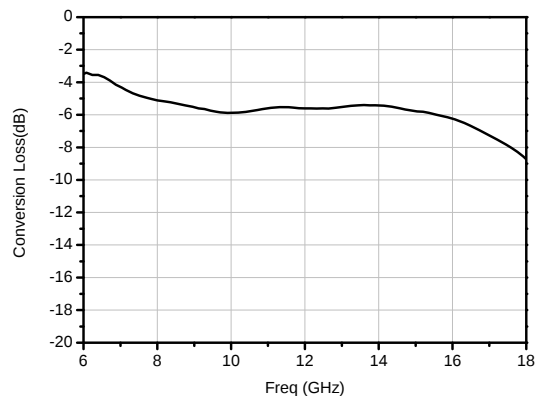
典型测试曲线

未注明情况下 IF=100MHz

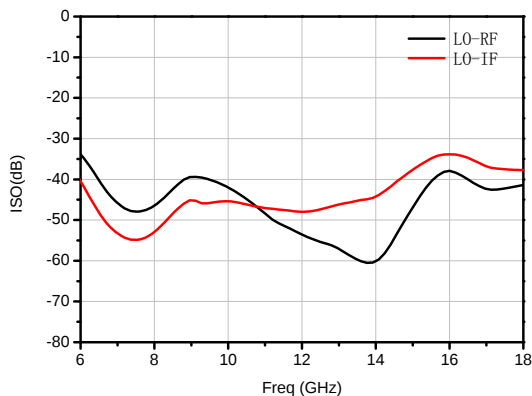
下变频损耗



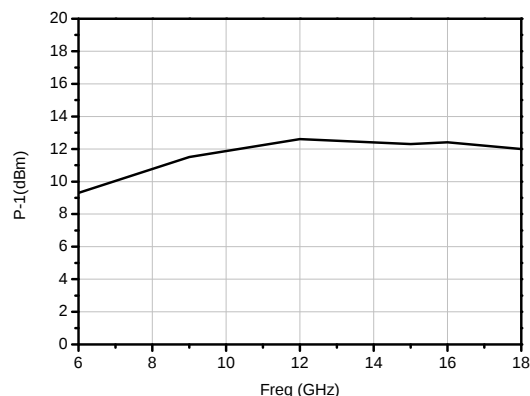
上变频损耗



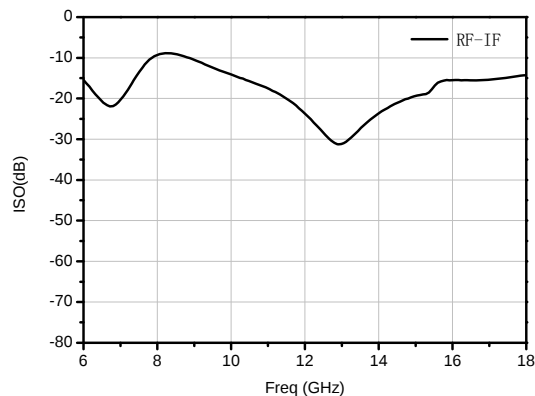
隔离度($\text{LO}=13\text{dBm}$)



输入 1dB 压缩点

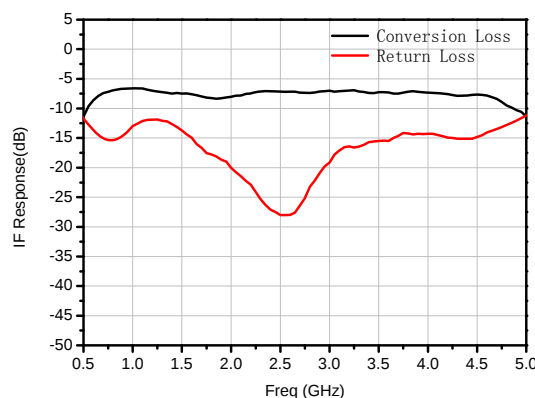


RF-IF 隔离度($\text{LO}=13\text{dBm}$)



中频带宽 $\text{LO}=\text{RF}-\text{IF}=8\text{GHz}$

中频响应



杂散

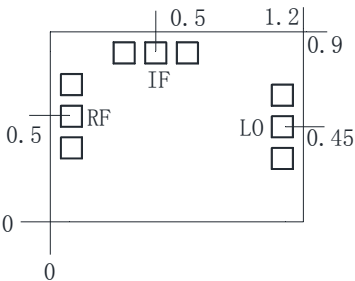
RF=8GHz@-10dBm					
L0=7.9GHz@+13dBm					
	n×L0				
m×RF	0	1	2	3	4
0	×	5	32	32	39
1	9	0	24	39	35
2	70	56	60	50	63
3	55	84	67	51	70
4	84	86	80	80	78
所有值为 1×RF-1×L0=IF 的相对值(dBc)					

注意事项

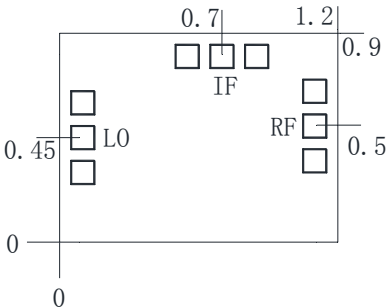
1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片输入输出端均无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

外形和端口尺寸（mm）

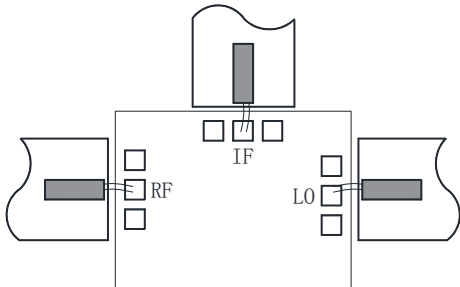
HG126HB



HG126HB(M)



推荐装配图



绝对额定最大值

最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃